



公益社団法人応用物理学会 応用電子物性分科会主催  
応用電子物性分科会研究例会

## 半導体素子の放熱技術・フォノンエンジニアリングの最前線

◇日時： 2026年10月16日(金) 13:00~17:40

◇場所： 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター(<https://plaza.solacity.jp>)

半導体デバイス・モジュールの性能や信頼性は動作中の発熱・温度上昇によって制限されます。従ってそれらの放熱技術は重要な研究開発課題です。本研究例会では、熱伝導の物理、半導体実装、パワーデバイス、実装部材の第一線で活躍されている方々をお招きし、半導体素子の放熱技術の最新動向を基礎と応用の両側面から議論します。皆様ふるってご参加ください。

---

応用電子物性分科会 幹事長 挨拶 (13:00-13:05)

- 13:05-13:45 半導体デバイスの放熱に重要な物理 野村 政宏 (東京大)
- 13:45-14:25 ナノスケールの薄膜および界面の熱伝導の計測 八木 貴志 (産総研)  
14:25-14:40 休憩
- 14:40-15:20 先端半導体実装技術の開発動向と熱問題および放熱技術  
川野 連也 (東京大)
- 15:20-16:00 高放熱・高出力GaN on Diamond HEMT 柳生 栄治 (三菱電機)  
16:00-16:15 休憩
- 16:15-16:55 次世代大電力密度SiCデバイスパッケージ品の実現へ  
~高放熱実装構造から熱疲労信頼性設計まで~ 若本 恵佑 (ローム)
- 16:55-17:35 高放熱TIM実現のための窒化物フィラー開発 浜坂 剛 (トクヤマ)

閉会 (17:35-17:40)

---

■ 受付:以下のイベント登録webページより事前登録をお願いいたします。

[https://eventpay.jp/event\\_info?shop\\_code=3672191893354666&EventCode=C855468807](https://eventpay.jp/event_info?shop_code=3672191893354666&EventCode=C855468807)

■ 参加費(テキスト代・消費税込):

応用電子物性分科会会員 3,000 円

応用物理学会会員(分科会非会員) 7,000 円

応用物理学会会員(シニア会員) 2,000 円

一般 12,000 円, 一般学生 1,000 円

\*応電分科会の賛助会員の方は 1 社につき 1 名まで無料。2 名以上は通常通りの参加費。

■ 問合せ先:

重川 直輝 (大阪公立大)

E-mail: shigekawa@omu.ac.jp

野村 政宏 (東京大)

E-mail: nomura@iis.u-tokyo.ac.jp

木村 重哉 (東芝)

E-mail: shigeya.kimura.t80@mail.toshiba

吉田 千秋 (応用物理学会 事務局) E-mail: divisions@jsap.or.jp TEL: 03-3828-7723(直通)

(スパム対策のため上記“@”は全角になっています。半角の“@”に置き換えて下さい。)

応用電子物性分科会ホームページ: <http://annex.jsap.or.jp/ohden/>